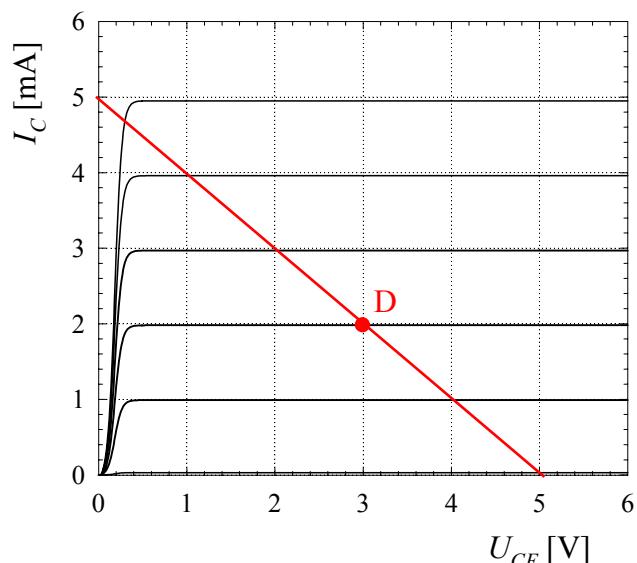
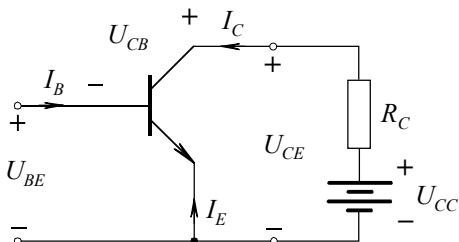


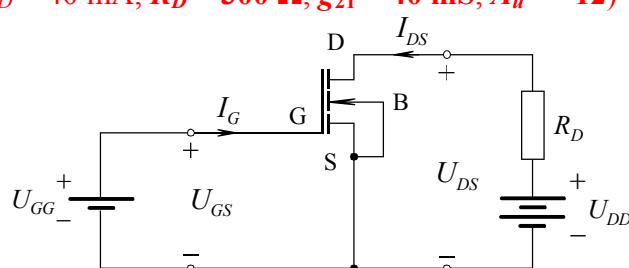
Pisni izpit pri predmetu
ELEMENTI POLPREVODNIŠKE ELEKTRONIKE
 I. stopnja VS – 2. letnik – Elektronika
 17. 6. 2020

- Za koliko se spremeni specifična prevodnost silicijevega vzorca n -tipa, če se zaradi osvetlitve poveča koncentracija večinskih in manjšinskih prostih nosilcev za $\Delta n = \Delta p = 9 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$?
 (Podatki: $\mu_p = 460 \text{ cm}^2/\text{Vs}$, $\mu_n = 3 \cdot \mu_p$).
 (Rešitev: $\Delta\sigma = 0,265 \text{ S/cm}$)
- Določite nadomestni model silicijeve diode s stopničastim p^+n spojem za majhne signale nizkih frekvenc, če je na diodo priključena zaporna napetost 12 V.
 (Podatki: $N_A = 100N_D$, $U_D = 709 \text{ mV}$, $A = 0,1 \text{ mm}^2$, $I_S = 2 \text{ nA}$)
 (Rešitev: $N_D = 1 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, $D = 3,99 \cdot 10^{-4} \text{ cm}$, $C_T = 2,5 \text{ pF}$)
- Za narisano vezje določite mirovni bazni tok I_B , tako da bo mirovna izhodna napetost $U_{CE} = 3 \text{ V}$. Vrišite delovno premico z mirovno delovno točko v priloženo izhodno karakteristiko bipolarnega tranzistorja in vpišite vrednosti baznih tokov za posamezne krivulje.
 (Podatki: $\alpha_F = 0,98$, $U_{CC} = 5 \text{ V}$, $R_C = 1 \text{ k}\Omega$)



(Rešitev: $\beta_F = 49$, $I_C = 2 \text{ mA}$, $I_B = 40,8 \mu\text{A}$, tokovi: 0, 20, 40, 60, 80, 100 μA)

- V danem vezju z MOS tranzistorjem določite upornost R_D tako, da bo izhodna napetost U_{DS} enaka polovici napajalne napetosti U_{DD} . Narišite nadomestno vezje za majhne signale, določite parameter g_{21} in izračunajte napetostno ojačenje vezja, ki je definirano kot amplitudno razmerje majhne izmenične komponente izhodne proti vhodni napetosti $A_u = u_{ds}/u_{gs}$.
 (Podatki: $U_{DD} = 24 \text{ V}$, $U_{GG} = 5 \text{ V}$, $U_T = 3 \text{ V}$, $C_0\mu_n = 2 \text{ mAV}^{-2}$, $W/L = 10$)
 (Rešitev: nasičenje, $I_D = 40 \text{ mA}$, $R_D = 300 \Omega$, $g_{21} = 40 \text{ mS}$, $A_u = -12$)



Pišete 60 minut, dovoljena je uporaba lista z osnovnimi enačbami in konstantami.
 Rezultati bodo objavljeni predvidoma jutri dopoldan v STUDIS-u.